			Справ. N	10		Перв. за	астосув.					
Формат	Зана	Позпачення Позначення		ДЧ <i>ЕННЯ</i>		Наименування			Кіл.	Прим.		
								Докуг	ментація	1		
A4			ДК81.4348	811.001 ПЕЗ			Блок вимірювання Перелік елементів			1		
A1			ДК81.4348	811.001 E3			Блок вимірювання Схема			1		
							електрична принципова					
A1			ДК81.750	706.001 CK			Плата Складальне креслення			1		
							<u>Деталі</u>					
A1		1	ДК81.758	725.001		Плата друкована			1			
								<u>Інші</u>	<u>βυροδυ</u>			
								<u>Конда</u>	енсатори			
		2					10 mkΦ 5 n	1M 5,4 MI	м 16 В С Hit	מחס	1	<i>C9</i>
		3 4 5 6 7 8			100 мкФ 5 мм 5,4 мм 16 В С Hitano			1	<i>C2</i>			
					47 MKΦ 5 MM 5,4 MM 16 B C Hitana C-0603 16 B 0,1 MKΦ 5 % X7R KEMET C-0603 16 B 1 MKΦ 5 % X7R KEMET		tano	1	<i>C7</i>			
							R KEMET	3	C4,C10,C11			
							KEMET	2	<i>C3,C8</i>			
					С-0603 16 В 20 пФ 5 % X7R KEMET			KEMET	2	<i>C5,C6</i>		
					С-0603 16 В 3,3 нФ 5 % X7R KEMET			KEMET	1	<i>C1</i>		
			•									
_	ı	_			<del> </del>							
							ДK87	1.75L	<i>3706.</i>	001 (	$\bigcap$	
	Зм. Арк. № докум. Підп. Дата Розроб. Юрченко В.О.						/lim.	Аркуш	и Аркушів			
	гозроо. Перев.		Адаменко І.С			Плата			1	3		
Н.к	Н.контр.				+	(	Специфікація КПІ ім.		KΠI im.	Ігоря Сі. фЕл пі	корського, К-81	
Заі			убар В.Г.				•			1	<b>₩</b>	. 01
_	IHB	Nº ⊓	одл.	Підп. т	а дата	В.эп.	м. iнв. №	luh	№ дубл.		Підп. та	а дата
							l l		_			

Формат	Зона	Позиція	Позначення	Наименування	Кіл.	Прим.	
				A.C.			
				<u>Мікросхеми</u>			
		9		AD9765ASTZ Analog Devices	1	DD5	
		10		AS7C34096A Alliance	1	DD2	
				Semiconductor Corporation			
		11		Atmega8–16AU ATMEL Corporation	1	DD4	
		12		CFPS-73-60M IQD	1	DA3	
		13		EPM3128ATC100-7 Intel	1	DD1	
		14		FT232BM FTDI	1	DD3	
		15		LM1117–3.3 Texas Instruments	2	DA1,DA2	
				Пристрої індикації			
				, ,			
		16		KT-SMD0603-G Kento	2	HL1,HL2	
				Котушки індуктивності			
		17		RLB0913-223K BOURNS	1	L1	
				<u>Резистори</u>			
				<u>r Essemepe</u>			
		18		R-0603 100 мВт 1 кОм 1 % Yageo	2	R3,R4	
		19		R-0603 100 мВт 1,5 кОм 1 % Yageo	1	R5	
		20		R-0603 100 mBm 110 0m 1 % Yageo	2	R9,R10	
		21		R-0603 100 мВт 2 кОм 1 % Yageo	2	R7,R8	
		22		R-0603 100 мВт 27 Ом 1 % Yageo	2	R1,R2	
		23		R-0603 100 mBm 470 0m 1 % Yageo	1	R6	
		24		R-0603 100 mBm 50 0m 1 % Yageo	1	R11	
					 7	Арк.	
ДК81.750706.001 СП 2 дата							
Iнв. № подл. Підп. та дата Взам. інв. № Інв. № дубл. Підп. та дата							
	IHD.	IV" NO	рдл. Підп. та дата Вэа.	м. інв. № Інв. № дубл.	ι ΙΙΟΠ. Μ	ע טעווום	

Формат	Зона	Позиція	Позначення	Наименування	Кіл.	Прим.
				<u>Перемикачі</u>		
		25		TL3301PF260QG E-Switch	3	SB1–SB3
				<u>Роз'єми</u>		
		26		51K2O4–40OA5Rosenberger	2	XS4,XS5
		27		PLD-10 (DS1021-2x5) Connfly	1	XP1
				electronic (Zhenqin)		
		28		PLD-16 (DS1021-2x8) Connfly	1	XS6
				electronic (Zhenqin)		
		29		SD-card Samsung	1	XS3
		30		UB-MC5BR3-SD204-4S NMPJST	2	XS1,XS2
				Sales America Inc.		
				<u>Кварцеві резонатори</u>		
		31		49S–SMD 6.0 MHz (18pF 30PPM) Strong	1	<i>ZQ1</i>
		32		KX-K 16.0 MHz	1	ZQ2
		<i>J</i> Z	(49S-SMD-16M-20PF-30PPM) Crystal			202
				1,775 0.12 10.1 20.7 20.7 1, 0.7 0.4.		
				<u>Матеріали</u>		
		33		Припій ПОС 61 ГОСТ 21930–76	102	
Зм.	Ад	DK.	№ докум. Підп. Дата	QK81.750706.001 CF	7	<i>Арк.</i> 3
	Інв.	Nº na	адл. Підп. та дата Вза	лм. інв. № Інв. № дубл.	Підп. ти	а дата